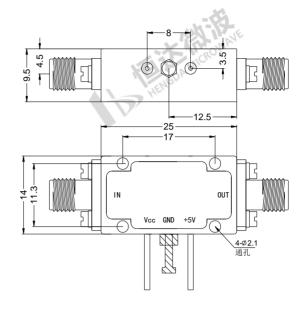


产品名称:吸收式压控衰减器

产品型号: HD-024VA30S





1. 详细技术参数(*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		0. 2-1	M	ROS	1-2			2-4	M	GHz
衰减范围		30	HENGD!		30			30	HENGLI	dB
插入损耗		2.8	3.5		3. 3	3.8		4.3	4.8	dB
插损随温度变化值		0. 01			0.01			0.01		dB/ ° C
输入驻波比 (插损状态下)		1.5	2.0		1.6	2. 0		1.8	2. 2	: 1
输出驻波比 (插损状态下)		1.5	2.0		1.6	2.0		1.8	2. 2	: 1
0.1dB压缩点		30			30			30		dBm
输入IP3值		50			50			50		dBm
切换时间			15			15			15	us
控制电压范围	0	10		0	10		0	10		V
重量	20	9. 92							g	
阻抗	NE	50						Ω		
电流	CROV	30						mA		
输入输出连接头	SMA-Female									
表面处理	镀金									
腔体材料		铝								
封装形式		标准封装(气密封装可选)								

地址: 西安市航天产业基地飞天路485号

邮箱: hd@hdmicrowave.com

电话: 029-85266226

传真: 029-85264764

网站: www.hdmicrowave.com

邮编: 710100

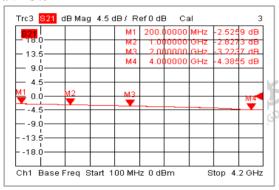


2. 额定参数与环境

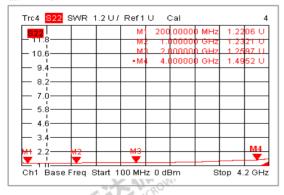
控制电压	0-13V					
射频输入功率	+30dBm					
工作温度	−45° C~+85° C					
存储温度	−55° C~+125° C					
2. H·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	762米 (环氧树脂密封条件)					
海拔高度	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件)(可选)					

3. 产品测试图

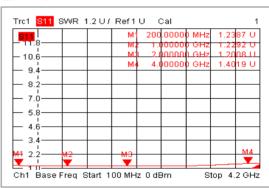
插入损耗(+25℃)



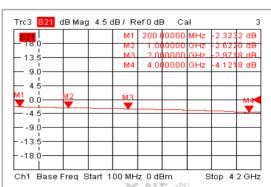
输出驻波比(+25℃)



输入驻波比(+25℃)



插入损耗(-45℃)



地址: 西安市航天产业基地飞天路485号

邮箱: hd@hdmicrowave.com

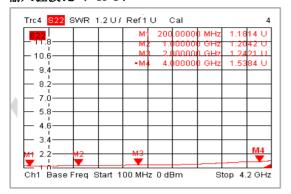
电话: 029-85266226

传真: 029-85264764

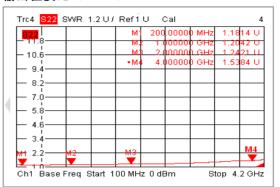
网站: www.hdmicrowave.com 邮编: 710100



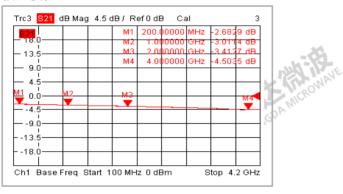
输入驻波比(-45℃)



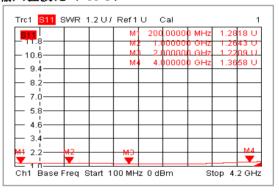
输出驻波比(-45℃)



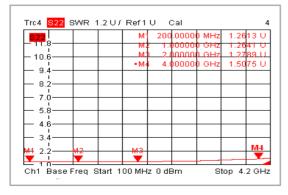
插入损耗(+85℃)



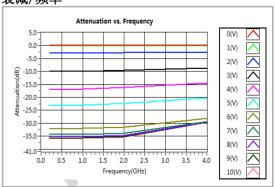
输入驻波比(+85℃)



输出驻波比(+85℃)



衰减/频率



邮箱: hd@hdmicrowave.com

地址: 西安市航天产业基地飞天路485号

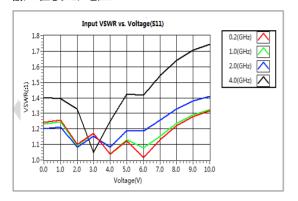
电话: 029-85266226

传真: 029-85264764

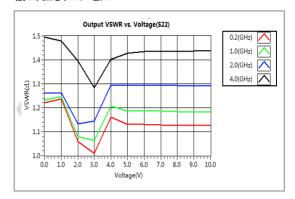
网站: www.hdmicrowave.com 邮编: 710100



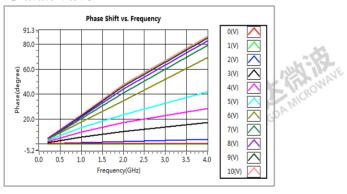
输入驻波比/电压



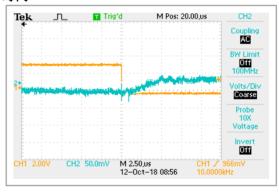
输出驻波比/电压



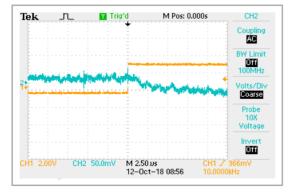
移相相位/频率



时间



时间





电话: 029-85266226

地址: 西安市航天产业基地飞天路485号

邮箱: hd@hdmicrowave.com

传真: 029-85264764

邮编: 710100 网站: www.hdmicrowave.com